大学基础物理学

University Fundamental Physics

电子工程系@华东师范大学

李波

2019年



§ 2.6 点电荷在外电场中的静电势能



$$A_{12} = \int_{(P_1)}^{(P_2)} P \cdot dl = \int_{(P_1)}^{(P_2)} q_0 P \cdot dl = q_0 \int_{(P_1)}^{(P_2)} P \cdot dl$$

点电荷的电势能: $W = q\varphi$

$$W = q \varphi$$

一个电荷在外电场中的电势能是一种相互作 用能,属于电荷与产生电场的电荷系所共有!

电势能的单位: J

常用单位: eV 1ev=1.6x10⁻¹⁹J

§ 2.7 点电荷系的静电能



点电荷的电势能:

$$W = q \varphi$$

$$W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}$$

点电荷系的相互作用能为:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i \varphi_i$$

q;以外所有点电荷在*q*;处的电势

$$W = \frac{1}{2} \int_{q} \varphi dq$$

电荷Q的所有电荷 在dq处的电势

§ 2.8 静电场的能量



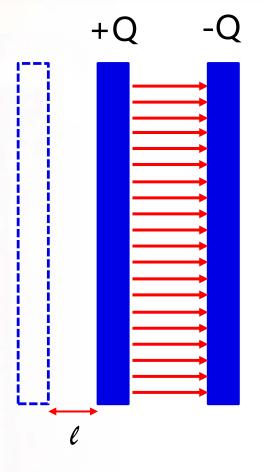
电荷系的静电能表示式

$$W = \frac{1}{2} \int_{q} \varphi \, \mathrm{d} q$$

似乎能量集中在电荷上。但从场的角度来看,

能量应该是储存在电场中。





$$F = fs = \frac{Q^2}{2\varepsilon_o S}$$

$$A = Fl = fsl = \frac{Q^2}{2\varepsilon_o S}l$$

$$W = A = \frac{Q^2}{2\varepsilon_o S}l$$

$$W = \frac{\varepsilon_o E^2}{2} Sl = \frac{\varepsilon_o E^2}{2} V$$



$$W = \frac{\varepsilon_o E^2}{2} Sl = \frac{\varepsilon_o E^2}{2} V$$

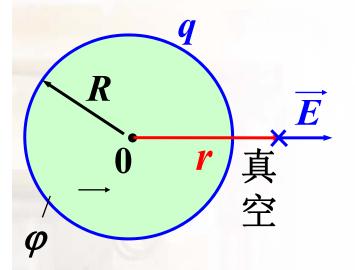
$$w_e = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon_o E^2}{2}$$

如果知道一个带电系统的电场分布,对全空间V进行积分

$$W = \int_{V} w_{e} dV = \int_{V} \frac{\varepsilon_{o} E^{2}}{2} dV$$



例,对均匀带电球体的电场能W:



其
$$\mathbf{w}_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (\frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2})^2$$

在球体内

$$\boldsymbol{w}_{e} = \frac{1}{2} \varepsilon_{0} E^{2} = \frac{1}{2} \varepsilon_{0} \left(\frac{qr}{4\pi \varepsilon_{0} R^{3}} \right)^{2}$$

$$W = \int_{0}^{R} \frac{\varepsilon_{0}}{2} \left(\frac{qr}{4\pi\varepsilon_{0}R^{3}} \right) \cdot 4\pi r^{2} dr + \int_{R}^{\infty} \frac{\varepsilon_{0}}{2} \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} \right) \cdot 4\pi r^{2} dr \qquad W = \frac{3q^{2}}{20\pi\varepsilon_{0}R}$$



例,对均匀带电球面的电场能W:

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \hat{r}$$

$$W = \int_{V} w_{e} dV = \int_{V} \frac{\varepsilon_{o} E^{2}}{2} dV$$

$$W = \int_{R}^{\infty} \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 r^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{4\pi \varepsilon_0 R}$$



$$W = rac{1}{2} \int_{q} \varphi \, \mathrm{d} \, q$$

球面电势
$$\varphi = rac{q}{4\pi\varepsilon_{0}R}$$

$$W = rac{1}{2} \int_{q} \varphi \, \mathrm{d} \, q = rac{1}{2} \varphi \cdot q = rac{1}{2} \cdot rac{q^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}R}$$

虽然如此,两种表示反映的却是两种不同观点。 在变化的电磁场中,电场储能的概念被证明为 不仅必要,而且是唯一客观的实在了。



真空中静电场小结提纲

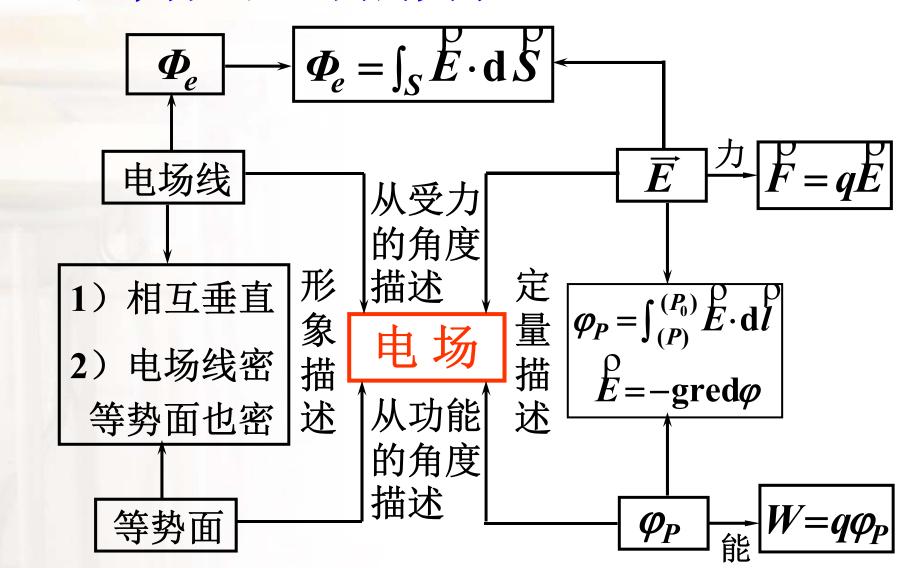
一. 线索(基本定律、定理):

库仓定律
$$\begin{bmatrix}
E = F/q_0 \\
E = \sum_i P_i
\end{bmatrix}
\rightarrow E = \sum_i \frac{q_i e_{r_i}}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}
\rightarrow
\begin{bmatrix}
\oint_E E \cdot dS = \frac{\sum_i q_h}{\varepsilon_0} \\
S = \sum_i P_i
\end{bmatrix}$$

还有电荷守恒定律,它时刻都起作用。



二. 基本物理量之间的关系:





三. 求场的方法:

1. 求E $\left\{\begin{array}{c} \rho \\ \vdots \end{array}\right\}$

叠加法(补偿法):
$$E = \sum_{i}^{\rho} E_{i}$$
,
$$E = \int_{q}^{\rho} \frac{\ell_{r}}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}} dq;$$
 高斯定理法:
$$\int_{s}^{\rho} E \cdot ds = \frac{\sum_{i}^{\rho} q_{h}}{\epsilon_{0}};$$

高斯定理法:
$$\oint_{s} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_{\text{b}}}{\varepsilon_{0}}$$

微分法:
$$\stackrel{\circ}{E} = -\nabla \varphi, \quad E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l}$$
.



场强积分法: $\varphi_p = \int_{-\infty}^{(P_0)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$,

(P) (E分段,积分也要分段);

2.求 φ 叠加法(补偿法): $\varphi = \sum_{i} \varphi_{i}$ (零点要同);

$$\varphi = \int_{q} \frac{\mathrm{d}\,q}{4\pi\varepsilon_{0}r}, \quad (\varphi_{\infty} = 0).$$



第三章 电容器和电介质

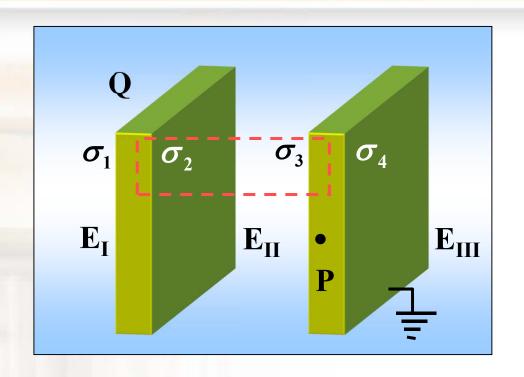
(Capacitor and Dielectric in Electrostatic Field)

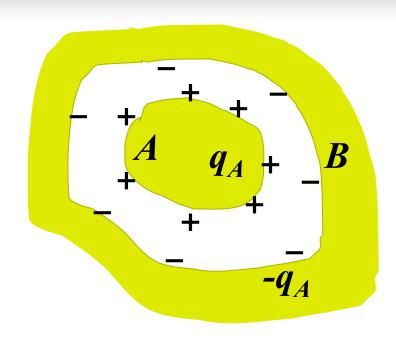
· 第一部分 电容 (Capacitor)

• 第二部分 有电介质存在时的 静电场 (Dielectric in Electrostatic Field)

§ 3.1 电容器及其电容







两个带有等值而异号电荷的导体所组成的系统,叫做电容器。

电容器两个极板所带的电量为+Q、-Q,它们的电势分别为 V_A 、

 $V_{\rm B}$, 定义电容器的电容为:

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{Q}{V_A - V_B}$$



$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{Q}{V_A - V_B}$$

电容的单位

法拉(F) 1F=1C.V-1

微法 1μF=10-6F

皮法 1pF=10⁻¹²F

关于电容的说明:

- •是导体的一种性质,与导体是否带电无关;
- •是反映导体储存电荷或电能的能力的物理量;
- •只与导体本身的性质和尺寸有关。

电容只与几何因素和介质有关

固有的容电本领

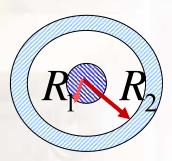


电容器的分类

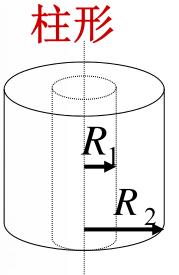
按形状分类:

平板电容器、圆柱形电容器、球形电容器

球形



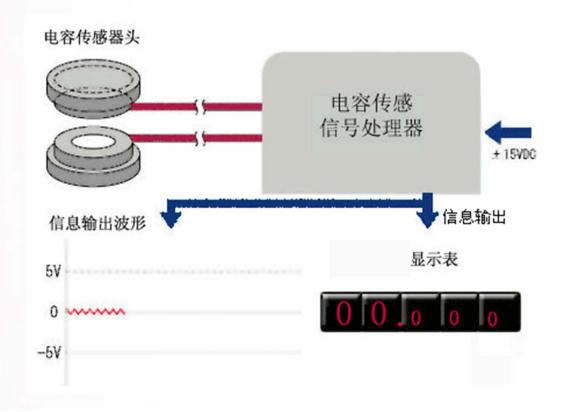
平行板







- 电容器的作用 •在电路中: 通交流、隔直流;
 - •与其它元件可以组成振荡器、时间延迟电路等;
 - •储存电能的元件;
 - •真空器件中建立各种电场;
 - •各种电子仪器。





电容器电容的计算

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{Q}{V_A - V_B}$$

计算电容的一般步骤为:

- •设电容器的两极板带有等量异号电荷Q;
- ·求出两极板之间的电场强度E的分布;
- ·计算两极板之间的电势差U;
- ·根据电容器电容的定义求得电容C=Q/U。



•例:真空中一个半径为R、带电量为Q的孤立球形导体的电容

$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 R$$

R=1m, C= $4\pi ε0 \sim 10^{-10}$ F

孤立导体的电容与导体的形状有关,与其带电量和电位无关。



平行板电容器

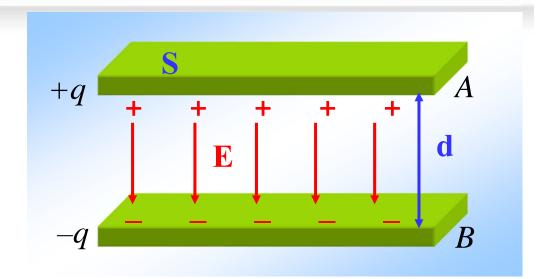
解 ① 设电容器两极板 带电± q;

> ② 板间电场: d 很小, S 很大,

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_o} = \frac{q}{\varepsilon_o S}$$

③ 板间电势差:

$$U_{AB} = E \cdot d = \frac{qd}{\varepsilon_o S}$$



④ 电容:
$$C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{\varepsilon_o S}{d}$$

平板电容器的电容与极板的面积成正比,与极板之间的距离成反比,还与电介质的性质有关。



球形电容器

解: 两极板间电场

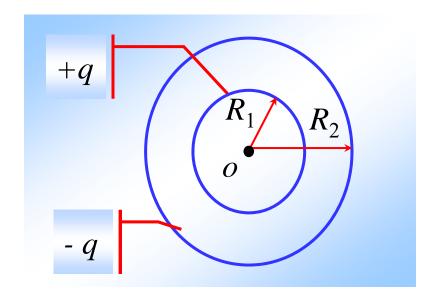
$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_o r^2} \qquad (R_1 < r < R_2)$$

板间电势差

$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_o} (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$$

电容

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_{o}R_{1}R_{2}}{R_{2} - R_{1}}$$



讨论: ①当 $R_2 \rightarrow \infty$ 时,

$$C=4\pi\varepsilon_{o}R_{1},$$

孤立导体球电容。



圆柱形电容器

解: 设两极板带电 ± q

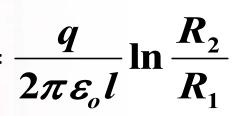
$$(l >> R_2 - R_1)$$

$$E = \frac{q}{2\pi\varepsilon_o rl} \qquad (R_1 < r < R_2)$$

$$(R_1 < r < R_2)$$

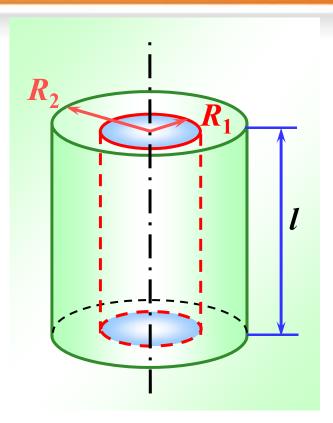
板间电势差
$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l}$$

$$=\frac{q}{2\pi\varepsilon_{o}l}\ln\frac{R_{2}}{R_{1}}$$





$$C = \frac{q}{U_{12}} = \frac{2\pi \varepsilon_o l}{\ln(R_2/R_1)}$$



•圆柱越长,电容越大;两圆柱 之间的间隙越小,电容越大。



圆柱形电容器的电容

$$C = \frac{q}{U_{12}} = \frac{2\pi \varepsilon_o l}{\ln(R_2/R_1)}$$

$$C \approx \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{d/R_1} \approx \frac{2\pi\varepsilon_0 lR_1}{d} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

•用d表示两圆柱面之间的间距,当d<< R_1 时

$$\ln \frac{R_2}{R_1} = \ln \frac{R_1 + d}{R_1} = \ln(1 + \frac{d}{R_1}) \approx \frac{d}{R_1}$$

平板电容器



1、平行板电容器:

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

2、球形电容器: 同心的金属球和金属球壳

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$
 $R_2 \to \infty$ $\to C = 4\pi\varepsilon_0 R_1$ 真空中孤立导体球的电容

3.柱形电容器的电容(L>>R₂-R₁)

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$$

电容只与介质及电 容器的结构有关



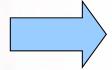
衡量电容器能力的两个指标:

1: 电容的大小

2: 耐电压能力

但实际情况是:

总希望电容大, 耐压能力强



电容器的并联和串联

§ 3.2 电容的联接



1、电容器的并联

特点:

每个电容器两端的电势差相等

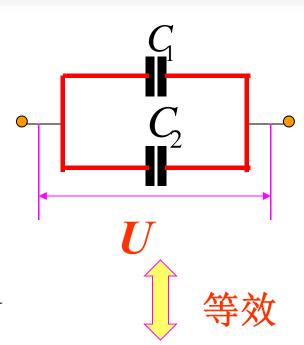
总电量:

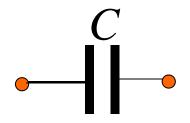
$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 U + C_2 U = (C_1 + C_2)U$$



等效电容:

$$C = \frac{Q}{U} = C_1 + C_2$$







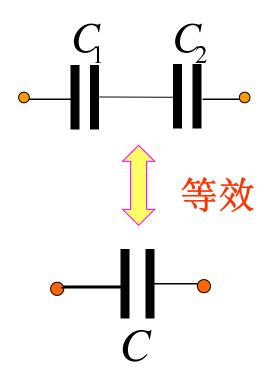
2、电容器的串联

特点:

每个电容器极板所带的电量相等

总电压

$$U = U_1 + U_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)Q$$

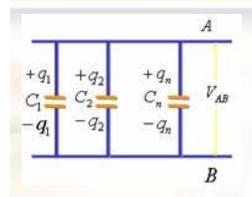


等效电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

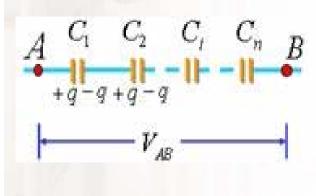




$$C = \frac{Q}{U} = C_1 + C_2$$

结论:

- •并联时,等效电容等于几个电容器电容之和;
- •各个电容器的电压相等;
- •并联使总电容增大。



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

结论:

- •串联时,其等效电容的倒数等于几个电容器电容的倒数之和;
- •等效电容小于任何一个电容器的电容,但可以提高电容的耐压能力:



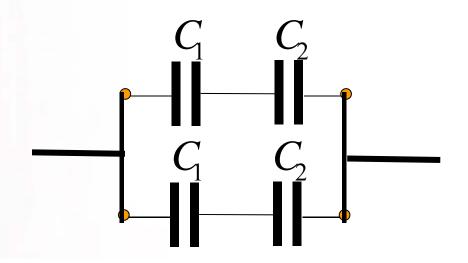
$$C = \sum_{i} C_{i}$$

$$\frac{1}{C} = \sum_{i} \frac{1}{C_{i}}$$

并联电容器的电容等于各个电容器电容的和。

串联电容器总电容的倒数等于各串联电容倒数之和。

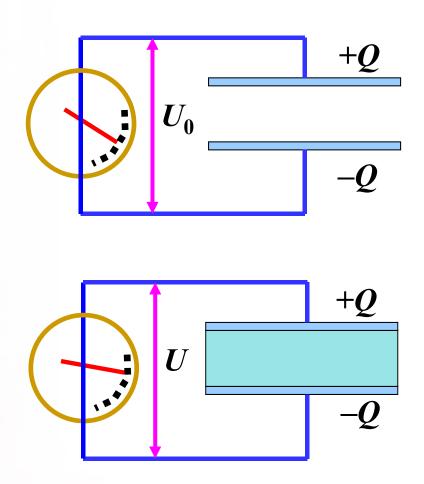
当电容器的耐压能力不被满足时,常用串并联使用来改善。串联使用可提高耐压能力,并联使用可以提高容量



§ 3.3 介电质对电场的影响



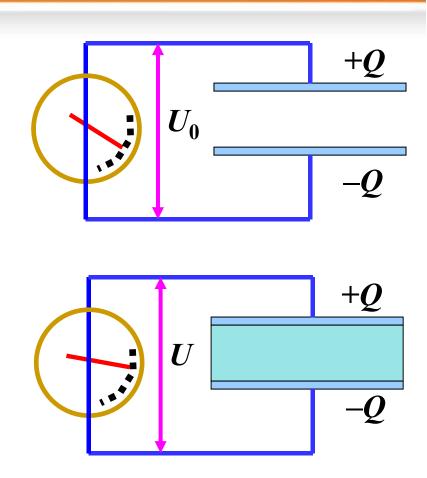
电介质对电容器电容影响





电介质对电容器电容影响

电容器充电后,撤去电源,使两极板上的电量维持恒定,测得充满电介质电容器两极板间的电压U,为真空电容器两极板间的电压U0的 $1/\epsilon_r$ 倍,即 $U=U_0/\epsilon_r$ 。因而,充满电介质电容器的电容为



$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q_0}{U_0 / \varepsilon_r} = \varepsilon_r C_0$$

极板间充满电介质所电容器的电容为真空电容的ε,倍。



电介质的相对电容率

ε_r 一介质的相对介电常数

(relative dielectric constant)

 $\varepsilon_r \geq 1$, 它与介质种类和状态(温度)有关

电介质中的电场强度

$$E_0 = U_0 / d$$

$$E = U/d = (U_0/\varepsilon_r)/d$$
$$= (U_0/d)/\varepsilon_r = E_0/\varepsilon_r$$

电介质内任 意点的电场 强度为原来 真空时电场 强度的1/ε,

§ 3.4 介电的极化

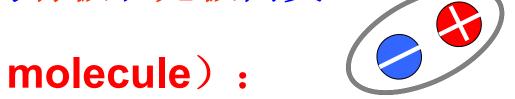






一.电介质分子可分为有极和无极两类

1.极性分子 (polar molecule):



分子电荷的正、负"重心"分开,

具有 固有电偶极矩,

p~10⁻³⁰ C·m。如:水,HCl,NH₃ ...

§ 3.4 介电的极化



2.非极性分子 (nonpolar molecule):

分子电荷的正、负"重心"重合,无固有电偶极矩。如: He, Ne, CH₄ ...

介质在电场中出现附加电荷称极化



甲烷



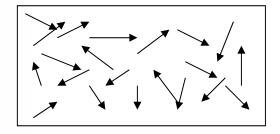


1、无外场时

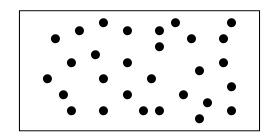
热运动---紊乱 电中性

因无序排列 对外总体不 呈现电性。

有极分子



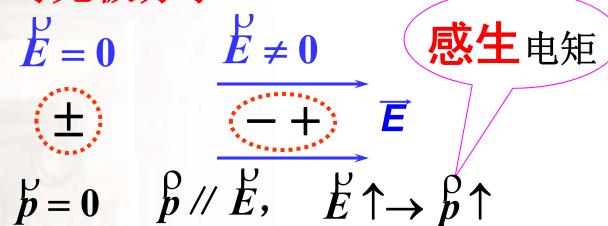
无极分子

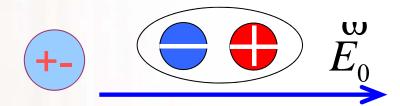




> 位移极化——无极分子的极化



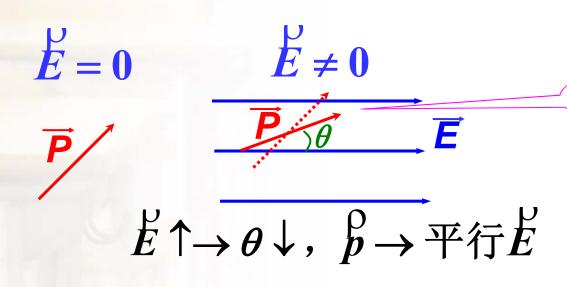




无感是固10外同越电分矩分板应有有5,加,强矩子的为地,以外,或地的约子的与相场生。

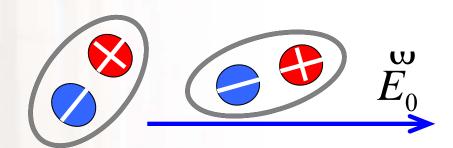


> 取向极化——有极分子的极化

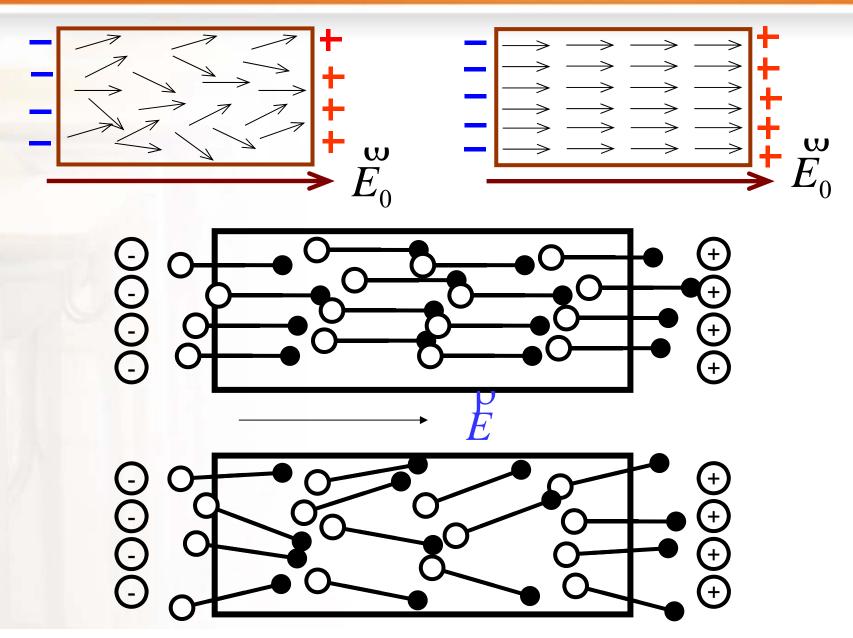


取向极化

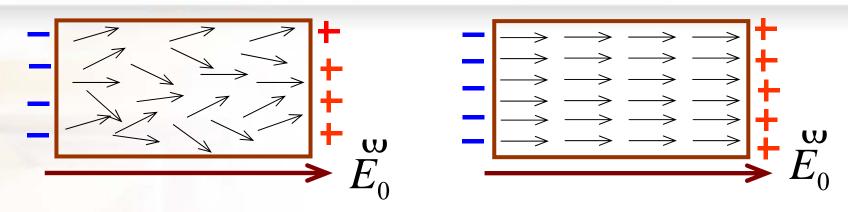
由于热运动,这种 取向只能是<mark>部分</mark> 的,遵守统计规 律。











结论: 极化的总效果是介质边缘出现电荷分布

由于这些电荷仍束缚在每个分子中,所以称之为面束缚电荷或面极化电荷。

外电场越强,电介质表面的 束缚电荷越多

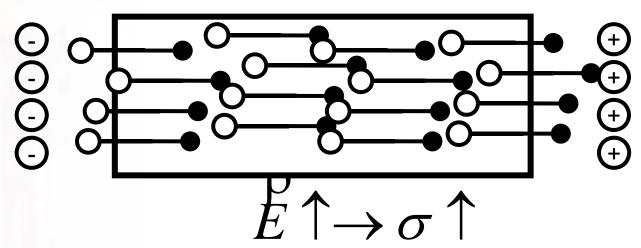
$$E \uparrow \rightarrow \sigma \uparrow$$

电介质的极化

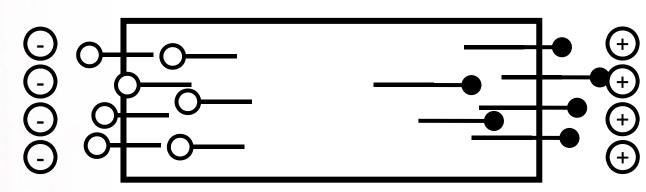


介电强度(击穿场强)



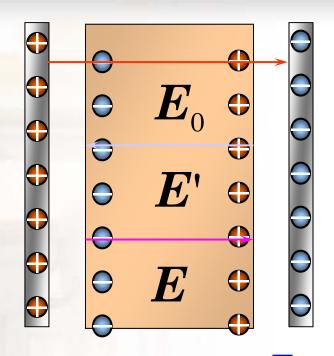


ET



电介质击穿 一介电强度(击穿场强)





$$E = E_0 + E'$$

 E_0^{∞} 自由电荷产生的场E' 束缚电荷产生的场

$$E = E_0 - E' \qquad E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$$

真空中:
$$\varepsilon_r = 1$$

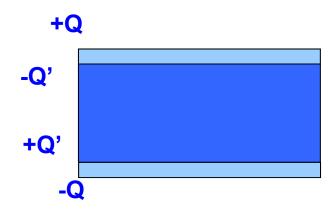
空气中:
$$\varepsilon_r \approx 1$$

$$\varepsilon_r \ge 1$$

为电介质的特征常 数称为电介质的 相对介电常数



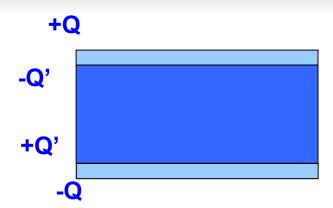
例:一平行板电容器间充满εr的电介质,求当它带电量为Q时,电介质面束缚电荷是多少?





理论分析
$$\sigma = \frac{Q}{S}$$
 $\sigma' = \frac{Q'}{S}$

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$



合场强

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_{0} - \boldsymbol{E}' = \frac{\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}}{\boldsymbol{\varepsilon}_{0}}$$

实验结果合场强

$$E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$$

$$E = \frac{\sigma - \sigma'}{\varepsilon_0} = \frac{E_0}{\varepsilon_r} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \sigma' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \sigma Q' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} Q$$

